

「FRAM®における 冗長回路技術と基準電圧可変回路技術」 第8回LSIデザイン・オブ・ザ・イヤー 優秀賞受賞

当社のFRAM® (Ferroelectric RAM) に関連した技術「FRAM®における冗長回路技術と基準電圧可変回路技術」が、半導体産業新聞社主催の第8回LSIデザイン・オブ・ザ・イヤーのデバイス部門優秀賞に選ばれました。この受賞に伴い、「第4回組込みシステム開発技術展」展示会場内特設会場にて、表彰式および表彰技術の展示が行われました。

このLSIデザイン・オブ・ザ・イヤーは、半導体産業新聞が最近のエレクトロニクス製品の中で、過去1年間を通じてLSI設計・開発に関する最も優れた製品を表彰することを目的に選定しているものです。本年は1840点におよぶ製品から選考委員会（委員長：東京大学 南谷崇教授）により書類審査が行われ、グランプリ1点と優秀賞3点が選出されました。

優秀賞を受賞した技術は、強誘電体キャパシタを活用することで従来技術では必須であったヒューズROMを不要にした冗長技術と、製造ばらつき

により動作マージンの少ない1T1Cメモリセルを事前に排除することを可能にした基準電圧可変技術です。前者の技術によって、ウェーハ・プロセスコストおよび試験コストの増加なしに歩留まり改善が可能となります。また、後者の技術と組み合わせることで歩留まりの犠牲を最小限に留め、FRAM®の信頼性の向上も図ることができます。

本技術の詳細解説につきましては次号FINDに掲載予定です。

*FRAM®は米国Ramtron International Corporationの登録商標です。



「電子デバイス製品」公開ホームページ リニューアル!



<http://edevic.fujitsu.com>

6月20日（当社創立記念日）に、「電子デバイス製品」公開ホームページトップを一新しました。お客様が必要な情報をタイムリーに掲載し、また見つけやすいようにコンテンツ改版も進めてまいります。ぜひ、ご覧ください!